

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5744353号
(P5744353)

(45) 発行日 平成27年7月8日(2015.7.8)

(24) 登録日 平成27年5月15日(2015.5.15)

(51) Int.Cl.

G01R 31/302 (2006.01)

F 1

G01R 31/28

L

請求項の数 12 (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2014-559747 (P2014-559747)
 (86) (22) 出願日 平成26年1月30日 (2014.1.30)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2014/052145
 (87) 国際公開番号 WO2014/119675
 (87) 国際公開日 平成26年8月7日 (2014.8.7)
 審査請求日 平成27年2月6日 (2015.2.6)
 (31) 優先権主張番号 特願2013-18683 (P2013-18683)
 (32) 優先日 平成25年2月1日 (2013.2.1)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

早期審査対象出願

(73) 特許権者 000236436
 浜松ホトニクス株式会社
 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
 (74) 代理人 100088155
 弁理士 長谷川 芳樹
 (74) 代理人 100113435
 弁理士 黒木 義樹
 (74) 代理人 100140442
 弁理士 柴山 健一
 (72) 発明者 中村 共則
 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
 浜松ホトニクス株式会社内
 (72) 発明者 西沢 充哲
 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
 浜松ホトニクス株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被検査デバイスである半導体デバイスに照射される光を発生する光発生部と、
 前記光発生部が発生した前記光が前記半導体デバイスに照射されたときに前記半導体デバイスで反射された反射光を検出し、検出信号を出力する光検出部と、
 前記半導体デバイスを駆動させる駆動信号を前記半導体デバイスに印加する駆動信号印加部と、

前記検出信号が入力される第1の電気計測部と、

前記検出信号及び前記駆動信号が選択的に入力される第2の電気計測部と、

前記光検出部と電気的に接続された第1の信号端子、前記駆動信号印加部と電気的に接続された第2の信号端子、及び、一端が前記第2の電気計測部と電気的に接続された接続部を有する切替部と、を備え、

前記切替部は、前記接続部の他端を前記第1の信号端子に接続することで前記第2の電気計測部に前記検出信号を入力させ、前記接続部の前記他端を前記第2の信号端子に接続することで前記第2の電気計測部に前記駆動信号を入力させる、半導体デバイス検査装置。

【請求項 2】

前記第1の電気計測部と前記第1の信号端子との間に設けられ、前記第1の信号端子から前記第1の電気計測部へ向かう方向に流れる電気信号を減衰する信号減衰部を更に備える、請求項1記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 3】

前記信号減衰部は、前記光検出部から前記第1の信号端子へ向かう電気信号を増幅し、前記第1の信号端子から前記第1の電気計測部へ向かう電気信号を減衰させる増幅器を有する、請求項2記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 4】

前記信号減衰部は、前記光検出部から前記第1の信号端子へ向かう電気信号を増幅する増幅器と、前記光検出部から前記第1の信号端子へ向かう電気信号、及び、前記第1の信号端子から前記第1の電気計測部へ向かう電気信号を減衰する減衰器と、を有する、請求項2記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 5】

前記信号減衰部は、グランドに電気的に接続された電気抵抗を有し、
前記切替部は、前記電気抵抗と電気的に接続された減衰切替部を有し、
前記切替部は、前記接続部の前記他端を前記第2の信号端子に接続する場合に、前記減衰切替部を前記第1の信号端子に電気的に接続する、請求項2記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 6】

前記信号減衰部は、グランドに電気的に接続された電気抵抗を有し、
前記切替部は、前記電気抵抗と電気的に接続された第3の信号端子、前記光検出部と電気的に接続された第4の信号端子、及び、一端が前記第1の信号端子と電気的に接続された中間接続部を更に有し、
前記切替部は、前記接続部の前記他端を前記第1の信号端子に接続する場合に、前記中間接続部を前記第4の信号端子に接続し、前記接続部の前記他端を前記第2の信号端子に接続する場合に、前記中間接続部を前記第3の信号端子に接続する、請求項2記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 7】

第1の電気計測部および第2の電気計測部は、複合波の各成分の振幅を測定する、第1のスペクトル分析部および第2のスペクトル分析部である、請求項1～6のいずれか一項記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 8】

前記切替部が前記他端を前記第2の信号端子に接続する場合に、前記第1のスペクトル分析部を動作させる基準信号の周波数及び位相と、前記第2のスペクトル分析部を動作させる基準信号の周波数及び位相とを同期させる信号同期部を更に備える、請求項7記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 9】

第1の電気計測部は、複合波の各成分の振幅を測定するスペクトル分析部であり、第2の電気計測部はロックイン增幅部である、請求項1～6のいずれか一項記載の半導体デバイス検査装置。

【請求項 10】

被検査デバイスである半導体デバイスに照射される光を発生する光発生工程と、
前記光発生工程において発生した前記光が前記半導体デバイスに照射されたときに、前記半導体デバイスで反射された反射光を検出し、検出信号を出力する光検出工程と、
前記半導体デバイスを駆動させる駆動信号を前記半導体デバイスに印加する駆動信号印加工程と、

前記検出信号を第1の電気計測部に入力する第1の測定工程と、
前記検出信号及び前記駆動信号を第2の電気計測部に選択的に入力する第2の測定工程と、を含む、半導体デバイス検査方法。

【請求項 11】

前記第2の測定工程において、前記検出信号を前記第2の電気計測部に入力した後に、前記駆動信号を前記第2の電気計測部に入力する、請求項10記載の半導体デバイス検査方法。

10

20

30

40

50

【請求項 1 2】

前記第2の測定工程において、前記駆動信号を前記第2の電気計測部に入力した後に、前記検出信号を前記第2の電気計測部に入力する、請求項10記載の半導体デバイス検査方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

集積回路を検査する技術として、EOP (Electro Optical Probing) や EOFM (Electro-Optical Frequency Mapping) と称される光プロービング技術が知られている。光プロービング技術では、光源から出射された光を集積回路に照射し、集積回路で反射された反射光を光センサで検出して、検出信号を取得する。そして、取得した検出信号において、目的とする周波数を選び出し、その振幅エネルギーを時間的な経過として表示したり、2次元のマッピングとして表示したりする。これにより、目的とした周波数で動作している回路の位置を特定することができる。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

【特許文献1】特開2007-64975号公報

20

【特許文献2】特開2001-255354号公報

【特許文献3】特開2010-271307号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

上述したような光プロービング技術は、集積回路等の半導体デバイスにおける故障個所及び故障原因などを特定し得ることから、極めて有効な技術である。

【0005】

そこで、本発明は、半導体デバイスの検査を効率良く且つ精度良く実施することができる半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法を提供することを目的とする。

30

【課題を解決するための手段】**【0006】**

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置は、被検査デバイスである半導体デバイスに照射される光を発生する光発生部と、光発生部が発生した光が半導体デバイスに照射されたときに半導体デバイスで反射された反射光を検出し、検出信号を出力する光検出部と、半導体デバイスを駆動させる駆動信号を半導体デバイスに印加する駆動信号印加部と、検出信号が入力される第1の電気計測部と、検出信号及び駆動信号が選択的に入力される第2の電気計測部と、光検出部と電気的に接続された第1の信号端子、駆動信号印加部と電気的に接続された第2の信号端子、及び、一端が第2のスペクトラムアナライザと電気的に接続された接続部を有する切替部と、を備え、切替部は、接続部の他端を第1の信号端子に接続することで第2の電気計測部に検出信号を入力させ、接続部の他端を第2の信号端子に接続することで第2の電気計測部に駆動信号を入力させる。

40

【0007】

この半導体デバイス検査装置では、切替部が接続部の接続先を第1の信号端子とした場合には、第1及び第2の電気計測部で2つの周波数における検出信号の同時計測が可能である。すなわち半導体デバイスの検査を効率的に行える。また、切替部が接続部の接続先を第2の信号端子として場合には、第1の電気計測部には検出信号が入力され第2の電気計測部には駆動信号が入力されることとなるため、検出信号の位相と駆動信号の位相とから位相差が算出でき、該位相差より故障個所及び故障原因を特定できる。すなわち、半導

50

体デバイスの検査を精度良く行うことができる。以上より、この半導体デバイス装置によれば、半導体デバイスの検査を効率良く且つ精度良く実施することができる。

【0008】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置では、第1の電気計測部と第1の信号端子との間に設けられ、切替部が第1の信号端子に接続していた他端を第2の信号端子に接続する場合に、第1の信号端子から第1の電気計測部へ向かう方向に流れる電気信号を減衰する信号減衰部を更に備えてもよい。この構成によれば、切替部が他端の接続を第1の信号端子から第2の信号端子に切り替えた際に、第1の信号端子から第1の電気計測部に向かって流れる駆動信号を適切に減衰できる。これにより、ノイズ信号が第1の電気計測部に入力されることを防止でき、検出信号と駆動信号との位相差をより精度良く算出できる。

10

【0009】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置では、信号減衰部は、光検出部から第1の信号端子へ向かう電気信号を増幅し、第1の信号端子から第1の電気計測部へ向かう電気信号を減衰させる増幅器を有してもよい。また、信号減衰部は、光検出部から第1の信号端子へ向かう電気信号を増幅する増幅器と、光検出部から第1の信号端子へ向かう電気信号、及び、第1の信号端子から第1の電気計測部へ向かう電気信号を減衰する減衰器と、を有してもよい。また、信号減衰部は、グランドに電気的に接続された電気抵抗を有し、切替部は、電気抵抗と電気的に接続された減衰切替部を有し、切替部は、接続部の他端を第2の信号端子に接続する場合に、減衰切替部を第1の信号端子に電気的に接続してもよい。また、信号減衰部は、グランドに電気的に接続された電気抵抗を有し、切替部は、電気抵抗と電気的に接続された第3の信号端子、光検出部と電気的に接続された第4の信号端子、及び、一端が第1の信号端子と電気的に接続された中間接続部を更に有し、切替部は、接続部の他端を第1の信号端子に接続する場合に、中間接続部を第4の信号端子に接続し、接続部の他端を第2の信号端子に接続する場合に、中間接続部を第3の信号端子に接続してもよい。このような構成とすることで、ノイズ信号が第1の電気計測部に入力されることを防止でき、検出信号と駆動信号との位相差をより精度良く算出できる。

20

【0010】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置では、第1の電気計測部および第2の電気計測部は、複合波の各成分の振幅を測定する、第1のスペクトル分析部および第2のスペクトル分析部であってもよい。

30

【0011】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置では、切替部が他端を第2の信号端子に接続する場合に、第1のスペクトル分析部を動作させる基準信号の周波数及び位相と、第2のスペクトル分析部を動作させる基準信号の周波数及び位相とを同期させる信号同期部を更に備えてもよい。各スペクトラム分析部間で基準信号の周波数及び位相を同期することで、各スペクトラム分析部の動作に起因する位相差が重畠されることが防止されるため、検出信号と駆動信号との位相差をより精度良く算出できる。

【0012】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査装置では、第1の電気計測部は、複合波の各成分の振幅を測定するスペクトル分析部であり、第2の電気計測部はロックイン増幅部であってもよい。

40

【0013】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査方法は、被検査デバイスである半導体デバイスに照射される光を発生する光発生工程と、光発生工程において発生した光が半導体デバイスに照射されたときに、半導体デバイスで反射された反射光を検出し、検出信号を出力する光検出工程と、半導体デバイスを駆動させる駆動信号を半導体デバイスに印加する駆動信号印加工程と、検出信号を第1の電気計測部に入力する第1の測定工程と、検出信号及び駆動信号を第2の電気計測部に選択的に入力する第2の測定工程と、を含む。この半導体デバイス検査方法によっても、上述した半導体デバイス検査装置と同様の理由により

50

、半導体デバイスの検査を効率良く且つ精度良く実施することができる。

【0014】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査方法では、第2の測定工程において、検出信号を第2の電気計測部に入力した後に、駆動信号を第2の電気計測部に入力することとしてもよい。第1及び第2の電気計測部で2つの周波数における検出信号を計測し効率的に異常周波数を特定するとともに、その後に検出信号と駆動信号の位相差から故障個所及び故障原因などを精度良く特定できる。

【0015】

本発明の一側面に係る半導体デバイス検査方法では、第2の測定工程において、駆動信号を第2の電気計測部に入力した後に、検出信号を第2の電気計測部に入力することとしてもよい。検出信号と駆動信号の位相差から故障個所と故障原因を特定するとともに、その後にノイズ除去等の処理を施すことができる。

10

【発明の効果】

【0016】

本発明の一側面によれば、半導体デバイスの検査を効率良く且つ精度良く実施することができる半導体デバイス検査装置及び半導体デバイス検査方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明の一実施形態の半導体デバイス検査装置の構成図である。

【図2】図1の半導体デバイス検査装置における周波数帯域の設定例を示すグラフである。

20

【図3】図1の半導体デバイス検査装置における周波数帯域の設定例を示すグラフである。

【図4】本発明の他の実施形態の半導体デバイス検査装置の構成図である。

【図5】本発明の他の実施形態の半導体デバイス検査装置の構成図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。

【0019】

30

図1に示されるように、半導体デバイス検査装置1は、被検査デバイス(DUT:Device Under Test)である半導体デバイス8において異常発生箇所を特定するなど、半導体デバイス8を検査するための装置である。半導体デバイス8としては、トランジスタ等のPNジャンクションを有する集積回路(例えば、小規模集積回路(SSI:Small Scale Integration)、中規模集積回路(MSI:Medium Scale Integration)、大規模集積回路(LSI:Large Scale Integration)、超大規模集積回路(VLSI:Very Large Scale Integration)、超々大規模集積回路(ULSI:Ultra Large Scale Integration)、ギガ・スケール集積回路(GSI:Giga Scale Integration))、大電流用/高圧用MOSトランジスタ及びバイポーラトランジスタ等がある。また、半導体デバイス8は、熱による変調を基板にかけられる半導体デバイスであってもよい。

40

【0020】

半導体デバイス検査装置1は、レーザ光源(光発生部)2を備えている。レーザ光源2は、第1電源(図示せず)によって動作させられ、半導体デバイス8に照射される光を射する。レーザ光源2から射出された光は、プローブ光用の偏光保存シングルモード光ファイバ3を介して、スキャン光学系5に導光される。スキャン光学系5は、スキャンヘッド6及びレンズ系7を有している。これにより、スキャン光学系5に導光された光は、半導体デバイス8の所定位置に結像され、当該光の照射領域は、半導体デバイス8に対して2次元的に走査される。なお、スキャン光学系5及び半導体デバイス8は、暗箱4内に配置されている。

【0021】

50

レーザ光源2から出射された光が半導体デバイス8に照射されたときに半導体デバイス8で反射された反射光は、戻り光用の光ファイバ9を介して、光センサ(光検出部)10に導光される。光センサ10は、第1電源(図示せず)と別体で設けられた第2電源(図示せず)によって動作させられ、反射光を検出して検出信号を出力する。光センサ10から出力された検出信号は、アンプ11を介して、分岐回路12に入力される。分岐回路12は検出信号を分岐して出力する。分岐された検出信号の一方はスペクトラムアナライザ(第1の電気計測部/第1のスペクトル分析部/第1のスペクトラムアナライザ)13に入力され、分岐された検出信号の他方は、アテネタ18、アンプ19、及び切替部17を介してスペクトラムアナライザ(第2の電気計測部/第2のスペクトル分析部/第2のスペクトラムアナライザ)14に入力される。なお、スペクトル分析部は、スペクトラムアナライザなどの複合波の信号の各成分の振幅を測定する電気計測手段である。

【0022】

スペクトラムアナライザ13, 14は、信号同期部15を介して互いに電気的に接続されている。また、スペクトラムアナライザ13, 14は、出力信号処理部16と電気的に接続されている。スペクトラムアナライザ13, 14は、入力された電気信号(詳細は後述)に基づき信号を生成し、該信号を出力信号処理部16に入力する。出力信号処理部16は、スペクトラムアナライザ13, 14により入力された信号に基づいて解析信号を生成し、該解析信号に基づく半導体デバイス像を形成し、当該半導体デバイス像を表示部20に表示させる。

【0023】

出力信号処理部16には、レーザスキャンコントローラ21が電気的に接続されている。レーザスキャンコントローラ21は、レーザ光源2及びスキャン光学系5を制御する。スペクトラムアナライザ13, 14には、テスタ、パルスジェネレータ及び電源を含むテスタユニット(駆動信号印加部)22が電気的に接続されている。テスタユニット22は、所定の変調周波数を有する駆動信号(テストパターン)を半導体デバイス8に印加する。これにより、半導体デバイス8は、検査時に駆動させられる。

【0024】

次に、切替部17、アテネタ18、アンプ19について、より詳細に説明する。切替部17は、スペクトラムアナライザ14に入力される信号を切り替える機能を有する。切替部17は、光センサ10と電気的に接続された検出信号端子(第1の信号端子)17aと、テスタユニット22と電気的に接続された駆動信号端子(第2の信号端子)17bと、一端17dがスペクトラムアナライザ14と電気的に接続された接続部17cと、を有している。切替部17によるスペクトラムアナライザ14に入力される信号の切り替えは、接続部17cの他端17eを検出信号端子17a又は駆動信号端子17bのいずれかに接続することにより行われる。すなわち、他端17eが検出信号端子17aに接続されている場合にはスペクトラムアナライザ14には分岐回路12により分岐された検出信号が入力され、他端17eが駆動信号端子17bに接続されている場合にはスペクトラムアナライザ14にはテスタユニット22から出力された駆動信号が入力される。なお、分岐回路12にアンプ19を接続し、切替部17の検出信号端子17aにアテネータ18を接続しても良い。

【0025】

アテネタ18及びアンプ19は、スペクトラムアナライザ13と検出信号端子17aとの間に設けられている。アテネタ18は、信号減衰部としての機能を有している。アテネタ18は、光センサ10から検出信号端子17aへ向かって流れる検出信号、検出信号端子17aからスペクトラムアナライザ13へ向かって逆流する反射信号、及び、検出信号端子17aからスペクトラムアナライザ13へ向かって流れるクロストーク信号、の各電気信号を減衰する。ここで、検出信号端子17aからスペクトラムアナライザ13に向かって逆流する反射信号とは、切替部17の他端17eが駆動信号端子17bに接続されている際に、分岐回路12から検出信号端子17aに向かって流れている検出信号のうち、例えば、切替部17の検出信号端子17aで反射しスペクトラムアナライザ13に

10

20

30

40

50

向かって逆流する信号をいう。また、検出信号端子 17a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れるクロストーク信号とは、切替部 17 の他端 17e が駆動信号端子 17b に接続されている状態において、駆動信号端子 17b からスペクトラムアナライザ 14 に向かって流れる駆動信号が、接続されていない検出信号端子 17a (もしくは配線) に、電気的作用によって漏れる (まわり込む) ことによって発生するスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる信号をいう。

【 0026 】

アンプ 19 は、光検出部 10 から検出信号端子 17a へ向かって流れる電気信号を所定の増幅率で増幅し、また、検出信号端子 17a からスペクトラムアナライザ 13 へ向かって流れる電気信号を減衰する。したがって、アンプ 19 は、信号増幅部としての機能と信号減衰部としての機能を両方とも有している。これにより、アンプ 19 は、光センサ 10 からアテネ タ 18 を介して検出信号端子 17a に向かって流れる検出信号を増幅するように設定されている。すなわち、光センサ 10 から出力された検出信号は、アテネ タ 18 で一度減衰された後、アンプ 19 によって減衰前の強度と同等になるように増幅される。また、アンプ 19 は、検出信号端子 17a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる反射信号及びクロストーク信号については、増幅せず、減衰させるように設定されている。このようなアンプ 19 としては、アイソレーションアンプやバッファアンプなどを用いることができる。また、アンプ 19 は、信号の増幅率を切り替える構成としても良い。この場合、アンプ 19 の増幅率を制御するアンプ制御部 (不図示) をさらに備え、アンプ制御部 (不図示) によって、入力された信号に対する増幅率を切り替える。これにより、アンプ 19 は、光検出部 10 から検出信号端子 17a に向かって流れる電気信号を所定の増幅率で増幅し、また、検出信号端子 17a からスペクトラムアナライザ 13 へ向かって流れる電気信号を、増幅しない、もしくは、低い増幅率で増幅する。

【 0027 】

次に、スペクトラムアナライザ 13, 14、信号同期部 15、出力信号処理部 16 について、より詳細に説明する。スペクトラムアナライザ 13 には検出信号が入力される。また、スペクトラムアナライザ 14 には検出信号及び駆動信号が選択的に入力される。具体的に、他端 17e が検出信号端子 17a に接続されている場合には、スペクトラムアナライザ 13, 14 には、光センサ 10 で検出された検出信号が入力される。この場合、出力信号処理部 16 は、スペクトラムアナライザ 13 に入力された検出信号に対して測定周波数帯域 FR1 を、スペクトラムアナライザ 14 に入力された検出信号に対して測定周波数帯域 FR2 を、それぞれ設定する。スペクトラムアナライザ 13 は測定周波数帯域 FR1 における検出信号から生成した信号を出力信号処理部 16 に入力する。また、スペクトラムアナライザ 14 は測定周波数帯域 FR2 における検出信号から生成した信号を出力信号処理部 16 に入力する。そして、出力信号処理部 16 は、スペクトラムアナライザ 13, 14 から入力された信号の差分を算出することにより、解析信号を取得する。

【 0028 】

また、切替部 17 の他端 17e が駆動信号端子 17b に接続されている場合には、スペクトラムアナライザ 13 には光センサ 10 で検出された検出信号が入力され、スペクトラムアナライザ 14 にはテスタユニット 22 により半導体デバイス 8 に印加される駆動信号もしくは駆動信号の繰り返し周波数の整数倍の信号がリファレンス信号として入力される。スペクトラムアナライザ 13 は検出信号から所定の周波数の信号を抽出し出力信号処理部 16 に入力する。スペクトラムアナライザ 14 はリファレンス信号の周波数の信号を抽出し出力信号処理部 16 に入力する。そして、出力信号処理部 16 は、スペクトラムアナライザ 13 により入力された信号と、スペクトラムアナライザ 14 により入力された信号との位相差を算出し、該位相差に基づいた位相画像を作成する。このような位相差を算出する前提として、信号同期部 15 により、スペクトラムアナライザ 13 を動作させる基準信号の周波数及び位相と、スペクトラムアナライザ 14 を動作させる基準信号の周波数及び位相とが同期するように制御される。

【 0029 】

10

20

30

40

50

次に、半導体デバイス検査装置1を用いた2つの計測手法（第1及び第2の計測手法）について説明する。第1の計測手法は、検出信号端子17aに他端17eを接続して異常周波数を特定した後に、駆動信号端子17bに他端17eを接続し故障個所及び故障原因を特定する手法である。

【0030】

第1の計測手法では、まず、切替部17の他端17eを検出信号端子17aに接続する。このとき、スペクトラムアナライザ13, 14には、それぞれ光センサ10において検出された検出信号が入力される。なお、スペクトラムアナライザ13, 14それぞれに入力される検出信号は、複数の周波数の信号からなる。そして、出力信号処理部16に対して、スペクトラムアナライザ13が測定周波数帯域FR1の信号を抽出し出力するよう、スペクトラムアナライザ14が測定周波数帯域FR2の信号を抽出し出力するよう、それぞれ設定する。なお、測定周波数帯域FR1と測定周波数帯域FR2とは異なる周波数帯域である。

10

【0031】

上述した、出力信号処理部16の設定について説明する。例えば、テスタユニット22が、第1変調周波数を有する第1駆動信号、及び第1変調周波数と異なる第2変調周波数を有する第2駆動信号を半導体デバイス8に印加する場合において、それらの信号による変調を同時に観察するために、出力信号処理部16は、第1駆動信号の第1変調周波数及び第2駆動信号の第2変調周波数に基づいて、測定周波数帯域FR1及び測定周波数帯域FR2を設定する。すなわち、測定周波数帯域FR1は、第1駆動信号の第1変調周波数のN倍（Nは自然数）の周波数を含むように設定され、測定周波数帯域FR2は、第2駆動信号の第2変調周波数のN倍（Nは自然数）の周波数を含むように設定される。これによれば、図2に示されるように、スペクトラムアナライザ13で生成された測定周波数帯域FR1に基づく測定信号S1と、スペクトラムアナライザ14で生成された測定周波数帯域FR2に基づく測定信号S2との差分から、測定周波数帯域FR1, FR2において、それぞれ、半導体デバイス検査装置のもつ固有の雑音等が除去された解析信号が取得できる。当該解析信号は、出力信号処理部16によって、表示部20に振幅像が表示される。

20

【0032】

そして、表示部20に表示された解析信号の振幅像を確認し、通常の振幅像と異なる像となっている周波数を、故障に起因する信号を含む周波数（異常周波数）として特定する。なお、解析信号の振幅像確認は、異常周波数が取得されるまで、測定周波数帯域FR1, FR2の設定を変更し繰り返し行われる。

30

【0033】

そして、異常周波数が特定された場合には、切替部17の他端17eを、検出信号端子17aに接続された状態から駆動信号端子17bに接続された状態に切り替える。このとき、スペクトラムアナライザ13には光センサ10において検出された検出信号が、スペクトラムアナライザ14にはテスタユニット22により半導体デバイス8に印加される駆動信号が、それぞれ入力される。スペクトラムアナライザ13には、上述した異常周波数の検出信号が入力される。なお、信号同期部15の設定により、スペクトラムアナライザ13を動作させる基準信号の周波数及び位相と、スペクトラムアナライザ14を動作させる基準信号の周波数及び位相とを同期するように制御する。

40

【0034】

スペクトラムアナライザ13, 14から出力された信号は、出力信号処理部16に入力される。そして、出力信号処理部16により、スペクトラムアナライザ13, 14から出力された信号の位相差が算出され、該位相差に基づく位相画像が表示部20に表示される。このような位相画像は、スキャン光学系5に導光される半導体デバイス8における光の照射領域を変更し、各照射領域について作成される。位相画像は、位相差に基づいた色で表示される。照射領域毎のスペクトラムアナライザ13, 14から出力される信号の位相差として適正な色を把握しておくことで、該適正な色と乖離した色となっている（あるべ

50

き位相差となっていない箇所を、半導体デバイス8の故障箇所として特定できる。また、適正な色との乖離度合や、特定の色であるか否かなどによって、故障原因を特定できる。なお、故障原因とは、例えば半導体デバイス8の素子間の配線が切れている、高抵抗の部分がある、などである。

【0035】

つづいて、第2の計測手法について説明する。第2の計測手法は、駆動信号端子17bに他端17eを接続して位相差から故障箇所及び故障原因を特定した後に、検出信号端子17aに他端17eを接続し半導体デバイス検査装置のもつ固有の雑音が除去された信号を取得する手法である。

【0036】

第2の計測手法では、まず、切替部17の他端17eを駆動信号端子17bに接続する。このとき、スペクトラムアナライザ13には光センサ10において検出された検出信号が、スペクトラムアナライザ14にはテスタユニット22により半導体デバイス8に印加される駆動信号が、それぞれ入力される。出力信号処理部16に対しては、スペクトラムアナライザ13が検出信号の中から所定の周波数の信号を抽出し出力するように設定し、スペクトラムアナライザ14が駆動信号の周波数の信号を抽出し出力するように設定する。

【0037】

スペクトラムアナライザ13, 14から出力された信号は、出力信号処理部16に入力される。そして、出力信号処理部16により、スペクトラムアナライザ13, 14から出力された信号の位相差が算出され、該位相差に基づく位相画像が表示部20に表示される。このような位相画像は、スキャン光学系5に導光される半導体デバイス8における光の照射領域を変更し、各照射領域について作成される。位相画像は、位相差に基づいた色で表示される。位相画像から故障箇所を特定すると、該故障箇所が光の照射領域となるようにスキャン光学系5を調整する。

【0038】

そして、切替部17の他端17eを、駆動信号端子17bに接続された状態から検出信号端子17aに接続された状態に切り替える。このとき、スペクトラムアナライザ13, 14には、それぞれ光センサ10において検出された検出信号が入力される。なお、光センサ10からの信号は、複数の周波数の信号からなる。そして、出力信号処理部16に対して、図3に示すように、スペクトラムアナライザ13が所定の周波数帯域（測定用周波数帯域）FR1の信号を抽出し出力するように設定し、スペクトラムアナライザ14が半導体デバイス検査装置のもつ固有の雑音のうち周波数依存のない周波数帯域を加算したレベル以下となる周波数帯域（参照用周波数帯域）FR2の信号を抽出し出力するように設定する。

【0039】

そして、出力信号処理部16がスペクトラムアナライザ13及びスペクトラムアナライザ14から入力された信号の差分をとることで、ホワイトノイズが除去された信号（解析信号）を取得することができる。解析信号を用いることで、計測結果の高精度化が図られる。

【0040】

以上説明したように、半導体デバイス検査装置1では、半導体デバイス8に照射される光を発生する光発生工程と、光発生工程において発生した光が半導体デバイス8に照射されたときに半導体デバイス8で反射された反射光を検出し検出信号を出力する光検出工程と、半導体デバイス8を駆動させる駆動信号を半導体デバイス8に印加する駆動信号印加工程と、検出信号をスペクトラムアナライザ13に入力する第1の測定工程と、検出信号及び駆動信号をスペクトラムアナライザ14に選択的に入力する第2の測定工程と、を含む半導体デバイス検査方法が実施される。

【0041】

また、第2の測定工程は、上述したように、検出信号をスペクトラムアナライザ14に

10

20

30

40

50

入力した後に駆動信号をスペクトラムアナライザ14に入力する手法と、駆動信号をスペクトラムアナライザ14に入力した後に検出信号をスペクトラムアナライザ14に入力する手法とがある。

【0042】

このように、半導体デバイス検査装置1では、切替部17が他端17eの接続先を検出信号端子17aとした場合には、スペクトラムアナライザ13, 14で2つの周波数の振幅同時計測が可能である。すなわち、半導体デバイス8の検査を効率的に行える。また、切替部17が他端17eの接続先を駆動信号端子17bとして場合には、スペクトラムアナライザ13には検出信号が入力されスペクトラムアナライザ14には駆動信号が入力されることとなるため、検出信号の位相と駆動信号の位相とから位相差が算出でき、該位相差より故障個所及び故障原因を特定できる。すなわち、半導体デバイス8の検査を精度良く行うことができる。以上より、この半導体デバイス検査装置1によれば、半導体デバイス8の検査を効率良く且つ精度良く実施することができる。

【0043】

また、切替部17が他端17eを駆動信号端子17bに接続する場合に、スペクトラムアナライザ13を動作させる基準信号の周波数及び位相と、スペクトラムアナライザ14を動作させる基準信号の周波数及び位相とを同期させる信号同期部15を備えることで、各スペクトラムアナライザ13, 14間の基準周波数の誤差に起因する位相差が重畠されることが防止されるため、検出信号と駆動信号との位相差をより精度良く算出できる。

【0044】

また、スペクトラムアナライザ13と検出信号端子との間に設けられ、切替部17が検出信号端子に接続していた他端17eを駆動信号端子17bに接続する場合に、検出信号端子からスペクトラムアナライザ13へ向かう方向に流れる電気信号を減衰する信号減衰部を更に備えることで、切替部17が他端17eの接続を検出信号端子17aから駆動信号端子17bに切り替えた際に、検出信号端子17aからスペクトラムアナライザ13に向かって逆流する検出信号、及び、検出信号端子17aからスペクトラムアナライザ13に向かって流れる駆動信号を適切に減衰できる。これにより、ノイズ信号がスペクトラムアナライザ13に入力されることを防止でき、検出信号と駆動信号との位相差をより精度良く算出できる。

【0045】

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、半導体デバイス8に照射される光を発生する光発生部は、レーザ光源2に限定されず、スーパールミネッセントダイオード等の他の光源であってもよい。また、半導体デバイス8に対し、電気信号に代えて、熱を印加してもよい。また、第1の電気計測部および第2の電気計測部としては、スペクトラムアナライザなどのスペクトル分析器に限らず、ロックインアンプやオシロスコープなどさまざまな電気計測機器（またはそれらの機能を有する装置）でもよい。また、それらの電気計測機器を組み合わせてもよく、例えば、第1の電気計測部としてスペクトラムアナライザを、第2の電気計測部としてロックインアンプを採用してもよい。さらに、複数のスペクトル分析部を備えるスペクトラムアナライザを用いても良い。このようなスペクトラムアナライザは、スペクトラムアナライザ13に相当する第1の電気計測部に信号を入力する第1のチャンネルとスペクトラムアナライザ14に相当する第2の電気計測部に信号を入力する第2のチャンネルを備えており、第1のチャンネルは、分岐回路12に電気的に接続され、第2のチャンネルは切替部17の他端17dに電気的に接続される。

【0046】

また、図4に示される半導体デバイス検査装置1xのように、信号減衰部として、グラウンド端子23bに接続された電気抵抗23aを有する信号減衰機構23を備えるとともに、一端が該電気抵抗23aと接続された減衰切替部17fを備え、切替部17が検出信号端子17aに接続していた他端17eを駆動信号端子17bに接続する場合に、減衰切替部17fの電気抵抗23aと接続されていない側の端部が検出信号端子17aに接続され

10

20

30

40

50

る構成であってもよい。この構成によれば、切替部 17 が他端 17 e の接続を検出信号端子 17 a から駆動信号端子 17 b に切り替えた場合に、減衰切替部 17 f が検出信号端子 17 a に接続されるため、検出信号端子 17 a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる電気信号はグランドに出力されることとなる。よって、検出信号端子 17 a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる電気信号を適切に減衰できる。なお、検出信号端子 17 a と分岐回路 12 との間にアテネータ 18 とアンプ 19 から構成される信号減衰部を更に備えても良い。

【0047】

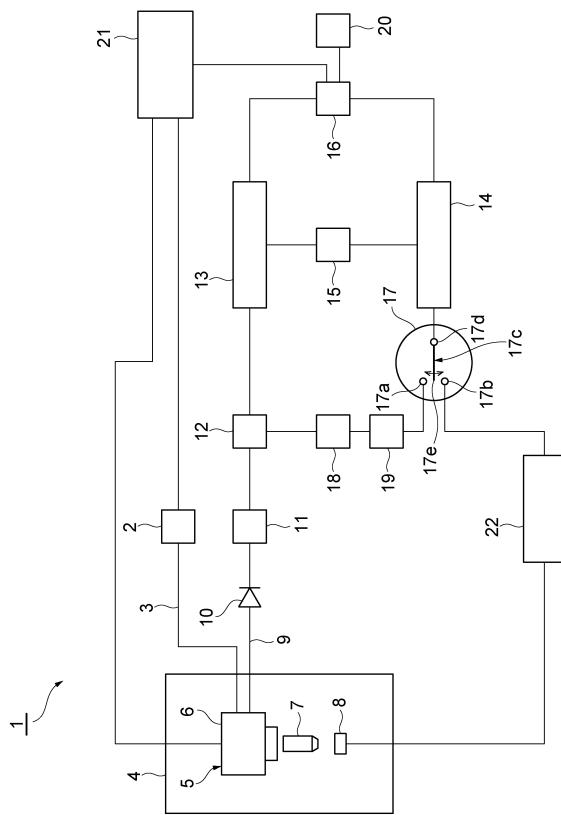
また、図 5 に示される半導体デバイス検査装置 1y のように、信号減衰部として、グランド端子 25 b に接続された電気抵抗 25 a を有する信号減衰機構 25 を備えるとともに、分岐回路 12 と電気的に接続された分岐回路端子（第 4 の信号端子）24 a と、電気抵抗 25 a と電気的に接続された減衰端子（第 3 の信号端子）24 b と、一端が検出信号端子 17 a と電気的に接続され他端と、分岐回路端子 24 a が減衰端子 24 b 又は一端が検出信号端子 17 a と電気的に接続され他端のいずれかと電気的に接続可能とされた中間接続部 24 c と、から構成された中間切替部 24 を有してもよい。この構成によれば、切替部 17 が他端 17 e を検出信号端子 17 a に接続している場合には中間接続部 24 c を一端が検出信号端子 17 a と電気的に接続され他端に接続し、切替部 17 が他端 17 e の接続を検出信号端子 17 a から駆動信号端子 17 b に切り替えた場合には中間接続部 24 c を減衰端子 24 b に接続することで、分岐回路端子 24 a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる電気信号はグランドに出力されることとなる。よって、検出信号端子 17 a からスペクトラムアナライザ 13 に向かって流れる電気信号を適切に減衰できる。なお、分岐回路端子 24 a と分岐回路 12 との間にアテネータ 18 とアンプ 19 から構成される信号減衰部を更に備えても良い。

【符号の説明】

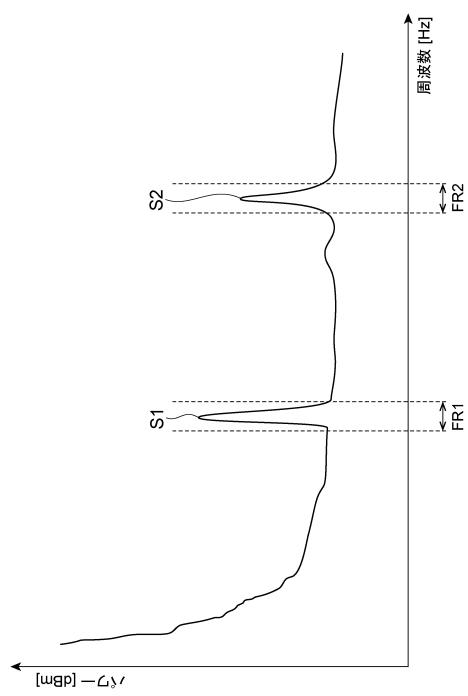
【0048】

1, 1x, 1y … 半導体デバイス検査装置、2 … レーザ光源（光発生部）、8 … 半導体デバイス、10 … 光センサ（光検出部）、12 … 分岐回路、13 … スペクトラムアナライザ（第 1 の電気計測部、第 1 のスペクトル分析部、第 1 のスペクトラムアナライザ）、14 … スペクトラムアナライザ（第 2 の電気計測部、第 2 のスペクトル分析部、第 2 のスペクトラムアナライザ）、15 … 信号同期部、16 … 出力信号処理部、17 … 切替部、17 a … 検出信号端子（第 1 の信号端子）、17 b … 駆動信号端子（第 2 の信号端子）、17 c … 接続部、17 d … 一端、17 e … 他端、17 f … 減衰切替部、18 … アテネータ（信号減衰部/減衰器）、19 … アンプ（信号減衰部/増幅器）、20 … 表示部、22 … テスター（駆動信号印加部）、23 a, 25 a … 電気抵抗、23 b, 25 b … グランド、24 a … 分岐回路端子（第 4 の信号端子）、24 b … 減衰端子（第 3 の信号端子）、24 c … 中間接続部。

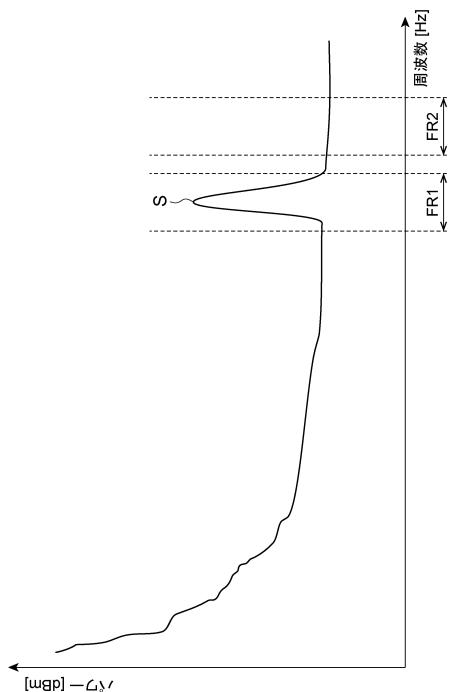
【図1】



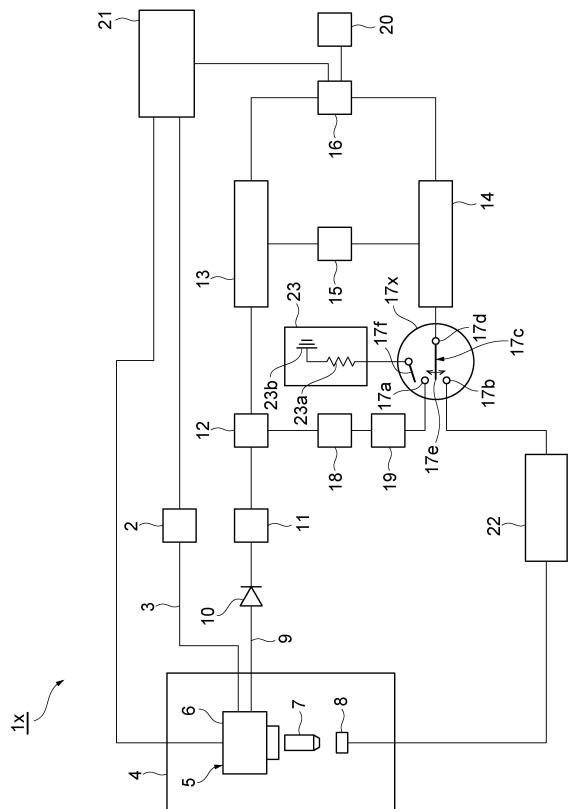
【図2】



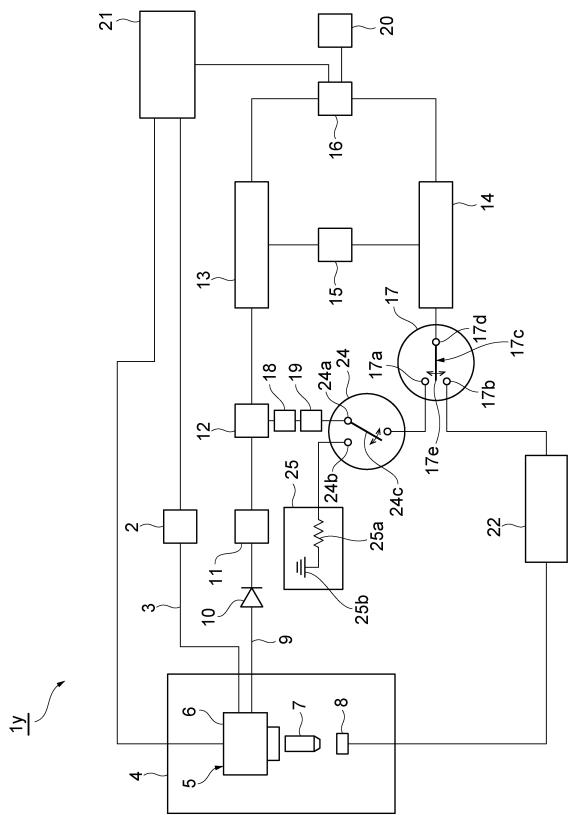
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

審査官 柳 重幸

(56)参考文献 特開平1-169862(JP,A)

特開平5-47883(JP,A)

特開平7-134147(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 01 R 31/28 - 31/3193

H 01 L 21/66